

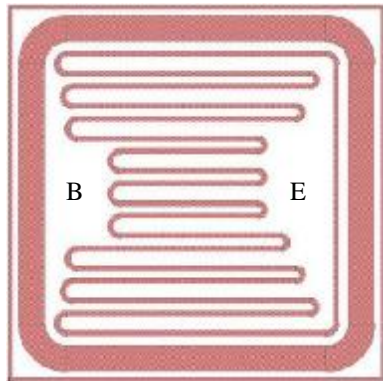
PJ163

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■芯片示意图



■芯片结构

片尺寸	1630 μ m \times 1630 μ m
压焊区尺寸	基 区 257 μ m \times 440 μ m 发射区 275 μ m \times 470 μ m
芯片厚度	240 \pm 10 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面: Al 3.0 \pm 0.4 μ m 背面: Ag 1.4 \pm 0.2 μ m

■电特性(T_a=25 $^{\circ}$ C)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单 位
集电极-基极反向电流	I _{CB0}	V _{CB} =620V		1		μ A
发射极-基极反向电流	I _{EB0}	V _{EB} =9V		1		μ A
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA	700		740	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	400		440	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	I _E =0.1mA	9			V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =200mA	15	30		
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =1A, I _B =200mA		0.5		V
特征频率	f _T	V _{CE} =10V, I _C =200mA	5			MHz
贮存时间	t _s	I _C =250mA	1.7	3.8		μ s